



Ф.И.О.: Асатова Умида Палвановна  
 ДОЛЖНОСТЬ: старший преподаватель  
 ТЕЛ: +99893 746 27 57  
 E – mail: [umida72@rambler.ru](mailto:umida72@rambler.ru);  
[asatova.umida72@gmail.com](mailto:asatova.umida72@gmail.com)  
[umida72@urdu.uz](mailto:umida72@urdu.uz)  
 ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700  
 АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100

<b>ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1989 - 1994 Ташкентский государственный университет (студент)</li> <li>• 1994-1995 Ургенчский государственный университет(стажер)</li> <li>• 2017-2020 Ургенчский государственный университет(базовый докторант)</li> <li>• 2021 доктор философии (PhD) по физико-математическим наукам</li> </ul>
<b>ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1995 – 2001 ассистент преподаватель кафедры физики Ургенчского государственного университета.</li> <li>• 2001 – 2017 старший преподаватель кафедры физики Ургенчского государственного университета.</li> <li>• 2020 по настоящее время старший преподаватель кафедры физики Ургенчского государственного университета</li> </ul>
<b>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Физик.</li> </ul>
<b>ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Физика полупроводников и диэлектриков, Атомная физика, Ядерная физика</li> </ul>
<b>ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выращивание и изучение структурных, электрофизических и фотоэлектрических свойств полупроводниковых узкозонных твердых растворов.</li> </ul>
<b>ПУБЛИКАЦИИ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saidov A.S., Leyderman A.Yu, Usmonov Sh.N., Asatova U.P. Peculiarities of the Current–Voltage Characteristic of n-GaP–p-(InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> Heterostructures // Technical Physics Letters, 2020 .– Vol. 46, No.11. – pp. 1124–1127. (№3 Scopus, IF = 0.773)</li> <li>2. Saidov A., Usmonov Sh., Asatova U. Features of epitaxy of the layers of solid solutions (InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> on GaAs substrates // Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering. – Tashkent, 2020. –Vol. 2, No.6. – pp. 36–39. (01.00.00; №16)</li> <li>3. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П. Особенности эпитаксии слоев твердых растворов (InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> на GaAs подложках // Труды международной конференции “Тенденции развития современной физики полупроводников: Проблемы, достижения и перспективы”. – Ташкент, 28-мая 2020г.– С. 263-269.</li> </ol>

4. Asatova U. P., Features of current transfer in n-GaP-p-(InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> heterostructure // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. – Urgench, 2019. – No.5. – pp. 25–33. (01.00.00; №10)
5. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P., Ishniyozov T. Structural features of solid solutions (InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> films grown from a liquid phase on GaAs substrates and some photoelectric properties of heterostructures on their basis // Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. – Urgench, 2019. – No.3. – pp. 7–23. (01.00.00; №10)
6. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P. Growth of Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> Solid Solution Films and Study of Their Structural Properties and Some of Their Photoelectric Properties // Semiconductors. – New York, 2012.–Vol.46, No.8. – pp. 1088–1095. (№3 Scopus, IF = 0.691)
7. Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П. Температурные особенности вольт-амперных характеристик n-GaP-p-(InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> гетероструктур // Доклады Академии наук Республики Узбекистан. – Ташкент, 2010. – №5. – С.23–26. (01.00.00; №7)
8. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P. Active Solar Energy Material Science Thermoelectric Properties of n-Ge-p-(InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> Heterostructures // Applied Solar Energy, 2010. – Vol. 46, No. 2. – pp. 104–106 (№3 Scopus)
9. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P., Ismailov Sh.K. Growing and studying the photoelectric and electrical properties of epitaxial films Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> solid solutions // Scientific-Technical Journal Turin polytechnic university. – Tashkent, 2019. – No.1. – pp. 93–104.
10. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П., Ишниязов Т., Некоторые фотоэлектрические свойства гетероструктур на основе эпитаксиальных слоев твердых растворов (InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> полученных из жидкой фазы. Materials of international conference “The modern problems of renewable energy sources and sustainable environment”. – Tashkent, September 25-27, 2019. – pp. 42-47.
11. Saidov A.S., Usmonov Sh.N., Asatova U.P., Ismailov Sh.K. Growth of Ge<sub>1-x</sub> Sn<sub>x</sub> solid solution films by Liquid phase epitaxy and study of their photoelectric and structural properties // “2nd International Conference on Applied Science AeroSpace Engineering”. – Tokyo, Japan, June 24-25, 2019.
12. Асатова У.П., Усмонов Ш.Н. Исследование рельефа поверхности эпитаксиальной пленки TP Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> (0 ≤ x ≤ 0.03) // Respublika Imiy-Amaliy Konferensiyasi (RIAK-XII). – Tashkent, 18 may 2019. – С. 345–346.
13. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П., Исмоилов Ш.К. О структуре TP Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> // Мухаммад Ал-Хоразмий издошлар мавзусидаги Республика-илмий техникавий анжуман материаллари. – Урганч, 2018. – С. 64–66.
14. Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П. Выращивание и исследование фотоэлектрических свойств эпитаксиальных пленок твердого раствора Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> с нанокристаллами. // Физика ва уни ўқитишнинг долзарб муаммолари мавзусидаги илмий ва илмий-методик маколалар туплами. – Гулистон, 2018. – С. 111–129.
15. Саидов А.С., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П., Исмоилов Ш. К. О структуре TP Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> // Образование и воспитание. Международный журнал. – Казань, № 3.1. 2018. – С.24–26.
16. Саидов А.С., Усмонов Ш. Н., Асатова У.П. Структурные особенности TP Ge<sub>1-x</sub>Sn<sub>x</sub> (0 < x < 0.03) // Труды международной конференции . – Ташкент, 13–14 июня 2017. – С.49–53.
17. Асатова У.П., Исмаилов Ш. К. О возможности синтеза узкозонных твердых растворов замещения (InSb)<sub>1-x</sub>(Sn<sub>2</sub>)<sub>x</sub> // Al-Xorazmiy nomli Urganch davlat universitetining Imiy-metodik jurnali Ilm sarchashmalari. – Urganch, 2015. – №12. – С. 14–17.

18. Асатова У.П. Выращивание пленок  $(\text{InSb})_{1-x}(\text{Sn}_2)_x$  на арсенид-галлиевых подложках методом жидкофазной эпитаксии // Республика ёш олимлар ва иктидорли талабалар мактаб-семинари материаллари. Замонавий физиканинг долзарб муаммолари. – Самарканд, 28-29 мая 2010. – С. 106–110
19. Асатова У.П., Усмонов Ш.Н. Спектральная фоточувствительность  $n\text{-GaAs-p}-(\text{InSb})_{1-x}(\text{Sn}_2)_x$  структур // Материалы Республиканской конференции «Современная физика и ее перспективы». – Ташкент, 12–13 ноября 2009. – С.247–249.
20. Саидов А.С., Усмонов Ш.Н., Асатова У.П. Спектральная фоточувствительность  $n\text{-Ge-p-Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$  структур // Тезисы докладов 2-Международной научной конференции. Физика и Физическое образование: Достижения и перспективы развития. – Бишкек, 18-20 сентября 2008. – С.22.
21. Раззаков А.Ш., Асатова У.П., Исмоилов Ш.К. Синтез трехкомпонентных твердых растворов  $(\text{Sn}_2)_x(\text{InSb})_{1-x}$  // Материалы Республиканской научно-технической конференции с участием зарубежных ученых «Композиционные материалы: Структура, свойства и применение». – Ташкент, 27-28 июня 2008. – С.136–138.
22. Саидов М.С., Саидов А.С., Асатова У. П., Исмоилов Ш.К. “Рост, свойства и применение кристаллов” // Материалы IV Республиканской научной конференции. – Андижан, 2008. – С. 37–38.
23. Saidov A.S, Ismoilov Sh.K, Asatova U.P. Liquid phase epitaxy of solid solutions. // Magnetic and Superconducting Materials MSM 07. – Khiva, 25 th-30 th September, 2007. – pp.100–101.
24. Saidov A.S, Asatova U.P., Ismoilov Sh. K. Growing of the  $(\text{Sn}_2)_{1-x}(\text{InSb})_x$  epitaxial layers on the GaAs substrate from a liquid phase // Magnetic and Superconducting Materials MSM 07. – Khiva, 25 th-30 th September, 2007. – p.54.
25. Saidov A.S, Leyderman A.Yu, Ismoilov Sh.K., Asatova U.P. Electrical and photoelectrical properties of thin films on base  $n\text{-GaAs-p}-(\text{Sn}_2)_{1-x}(\text{InSb})_x$  structures // Magnetic and Superconducting Materials MSM 07. – Khiva, 25 th-30 th September, 2007. – p. 54.
26. Саидов А.С, Кошчанов Э.А., Раззаков А.Ш., Асатова У.П. Токовые характеристики  $\text{GaAs}-(\text{Sn}_2)_x(\text{InSb})_{1-x}$  гетероструктур // Труды конференции посвященной 60-летию Академии наук Республики Узбекистан и Физико-технического института «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». – Ташкент, 27-28 ноября 2003 . – С.342-343.
27. Саидов А.С., Раззаков А. Ш., Сапаров Д. В., Давлатов У.Т., Асатова У.П., Саидниёзов О. Некоторые электрофизические свойства  $n\text{GaAs-p}(\text{Sn}_2)_{1-x}(\text{InSb})_x$ // Вестник ГулГУ. – Гулистон, 2002. – №2. – С.3–7.
28. Саидов А.С., Раззаков А. Ш., Кошчанов Э.А., Асатова У.П. Кристаллизация слоев полупроводниковых твердых растворов  $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x$  из жидкой фазы // Труды второй международной научно-практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса, 28-31 мая 2001 . – С.273.